

1.9 GHz PHS 用シリコン高周波増幅器 IC

μ PC8218T5A は PHS など 1.9 GHz 帯パワー・アンプとして開発したシリコン IC で、ドライバ段、終段から成る 3 段アンプ構成となっております。

パッケージは高密度表面実装に適した 16 ピン・プラスチック TSON パッケージを採用しています。

特 徴

中出力電力	: $P_{out} = +20.5 \text{ dBm MIN. @ } P_{in} = -19 \text{ dBm, } f = 1.9 \text{ GHz}$
低消費電流	: $I_{op} = 150 \text{ mA TYP.}$
単電源電圧	: $V_{DS} = 3.0 \text{ V TYP.}$
高密度・面実装に最適	: 16 ピン・プラスチック TSON パッケージ (3.3 × 2.3 × 0.6 mm)

用 途

PHS 1.9 GHz など

オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μ PC8218T5A-E1	16 ピン・プラスチック TSON	8218	・ 12 mm 幅エンボス式テーピング ・ 8, 9 ピン側が送り丸穴 ・ 3 k 個 / リール

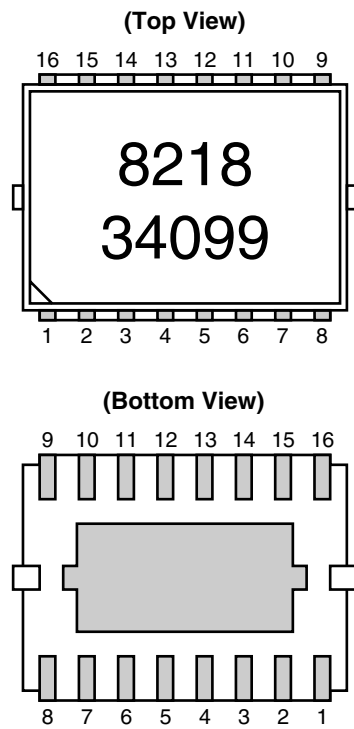
備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

サンプル名称： μ PC8218T5A

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

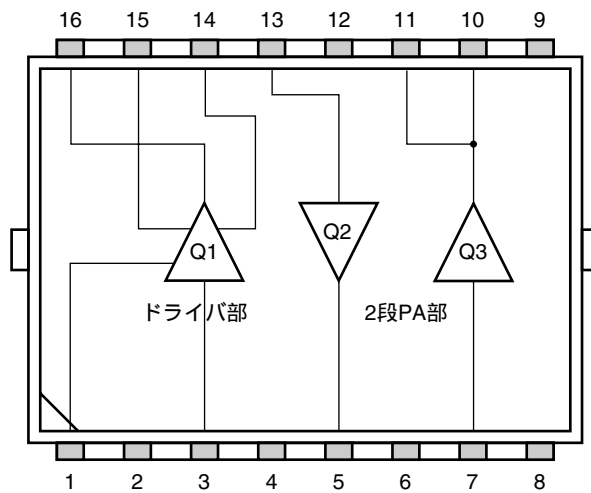
本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図



端子番号	端子名称
1	Vcc1
2	GND
3	INPUT1
4	GND
5	OUTPUT2
6	GND
7	INPUT3
8	NC
9	GND
10	OUTPUT3
11	OUTPUT3
12	GND
13	INPUT2
14	GND
15	GND
16	OUTPUT1

内部ブロック図



絶対最大定格 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^{\circ}\text{C}$)

項目	略号	条件	定格	単位
動作周囲温度	T_A		- 40 ~ + 85	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}		- 55 ~ + 150	$^{\circ}\text{C}$
チャンネル温度	T_{ch}		150	$^{\circ}\text{C}$
パッケージ許容損失	P_D	$T_A = +85^{\circ}\text{C}$ 注	4.33	W
ドライバ部 (Q1)				
電源電圧	V_{CC}		3.6	V
回路電流	I_{CC1}		60	mA
最大入力電力	P_{in1}		+ 10	dBm
2 段 PA 部 (Q2 + Q3)				
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}		8.0	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}		8.0	V
ドレイン電流 (Q2)	I_{DS2}		45	mA
ドレイン電流 (Q3)	I_{DS3}		259	mA
最大入力電力 (Q2)	P_{in2}		+ 12	dBm
最大入力電力 (Q3)	P_{in3}		+ 16	dBm

注 33 × 21 × 0.4 mm ガラス・エポキシ基板実装時

推奨動作範囲

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
動作周囲温度	T_A		- 40	+ 25	+ 85	$^{\circ}\text{C}$
ドライバ部 (Q1)						
電源電圧	V_{CC}		2.7	3.0	3.3	V
2 段 PA 部 (Q2 + Q3)						
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}		2.7	3.0	3.5	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	$T_A = +25^{\circ}\text{C}$	0	2.0	2.5	V
最大入力電力 (Q2)	P_{in2}	$V_{\text{DS}} = 3\text{ V}, T_A = +25^{\circ}\text{C}$		2.0	5.0	dBm
最大入力電力 (Q3)	P_{in3}	$V_{\text{DS}} = 3\text{ V}, T_A = +25^{\circ}\text{C}$		11.0	15.0	dBm

電气的特性 (特に指定のないかぎり $f = 1.9 \text{ GHz}$, $V_{CC} = V_{DS} = 3.0 \text{ V}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$)

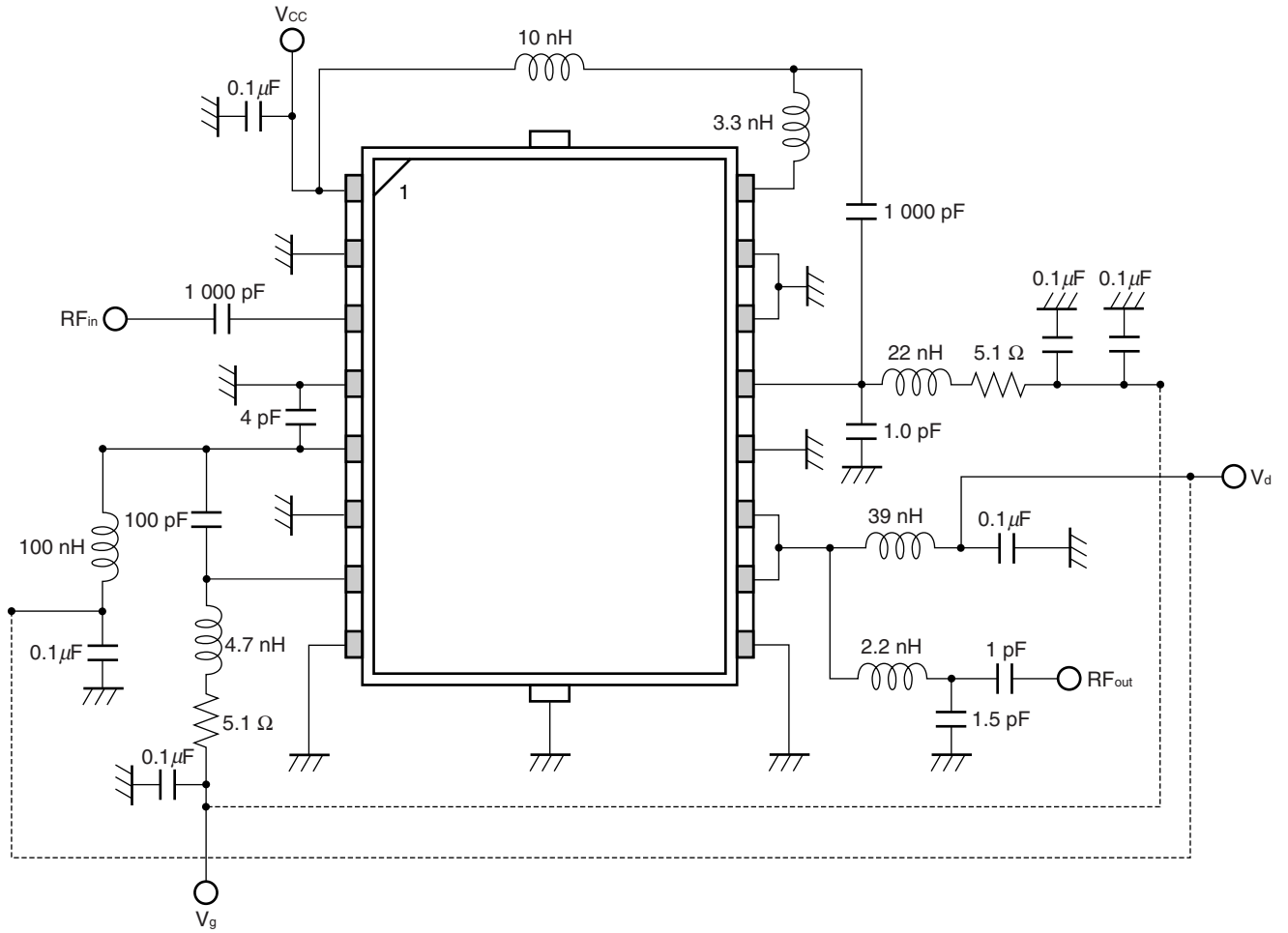
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドライバ+2段PA部 (Q1+Q2+Q3)						
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	$P_{in} = -19 \text{ dBm}$, $P_{out} = 20.5 \text{ dBm}$	1.2	1.8	2.3	V
電力付加効率	η_{add}		-	25.0	-	%
動作電流	I_{op}		-	150	175	mA
入力側リターン・ロス	RL_{in}	$P_{in} = -20 \text{ dBm}$	-	8	-	dB
出力側リターン・ロス	RL_{out}		-	3	-	dB
出力電力	P_{out}	$P_{in} = -19 \text{ dBm}$	20.5	-	-	dBm
電力利得	G_P		39.5	-	-	dB
線形利得	G_L	$P_{in} = -20 \text{ dBm}$	-	40.5	-	dB
隣接チャネル漏洩電力	$P_{adj}(600)$	$P_{in} = -19 \text{ dBm}$, $\Delta 600 \text{ kHz}$	-	-62	-55	dBc
	$P_{adj}(900)$		-	-70	-60	dBc
占有周波数帯	OBW	$P_{in} = -19 \text{ dBm}$	-	250.0	270.0	kHz
2次高調波	$2f_0$		-	-44	-	dBc
3次高調波	$3f_0$		-	-60	-	dBc
1 dB 利得圧縮時出力電力	$P_{O(1 \text{ dB})}$		-	21.0	-	dBm
ドライバ部 (Q1)						
回路電流	I_{CC}	無信号	-	23	-	mA
電力利得	G_P	$P_{in} = -30 \text{ dBm}$	-	21.0	-	dB
アイソレーション	ISL		-	32.0	-	dB
入力側リターン・ロス	RL_{in}		-	10.5	-	dB
出力側リターン・ロス	RL_{out}		-	10.0	-	dB
1 dB 利得圧縮時出力電力	$P_{O(1 \text{ dB})}$		-	8.5	-	dBm
飽和出力電力	$P_{O(sat)}$	$P_{in} = -5 \text{ dBm}$	-	10.0	-	dBm
2段PA部 (Q2+Q3)						
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	$P_{in} = -5 \text{ dBm}$, $P_{out} = 20.5 \text{ dBm}$	-	1.8	-	V
電力付加効率	η_{add}		-	30.0	-	%
ドレイン電流	I_{DS} 注		-	121	-	mA
入力側リターン・ロス	RL_{in}	$P_{in} = -20 \text{ dBm}$	-	10.0	-	dB
出力側リターン・ロス	RL_{out}		-	3	-	dB
出力電力	P_{out}	$P_{in} = -5 \text{ dBm}$	-	21.0	-	dBm
電力利得	G_P		-	26.0	-	dB
線形利得	G_L	$P_{in} = -20 \text{ dBm}$	-	26.0	-	dB
隣接チャネル漏洩電力 1	$P_{adj}(600)$	$P_{in} = -5 \text{ dBm}$, $\Delta 600 \text{ kHz}$	-	-60	-	dBc
隣接チャネル漏洩電力 2	$P_{adj}(900)$		-	-70	-	dBc
占有周波数帯	OBW	$P_{in} = -5 \text{ dBm}$	-	250.0	-	kHz
2次高調波	$2f_0$		-	-40	-	dBc
3次高調波	$3f_0$		-	-45	-	dBc
1 dB 利得圧縮時出力電力	$P_{O(1 \text{ dB})}$		-	21.0	-	dBm

注 2段PA部 (Q2とQ3) の全電流

DC 特性 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^{\circ}\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドライバ部 (Q1)						
回路電流	I_{CC}	$V_{CC} = 3.0\text{ V}$	-	23	30	mA
2 段 PA 部 (Q2)						
オン抵抗 2	R_{on2}	$V_{DS} = 0.1\text{ V}, V_{GS} = 6\text{ V}$	-	4.35	-	Ω
ドレイン・ソース間耐圧 2	BV_{DSS2}	$I_{DS} = 1.4\ \mu\text{A}$	10.0	12.0	16.0	V
ゲート・ソース間耐圧 2	BV_{GSS2}	$I_{GS} = 1.4\ \mu\text{A}$	6.0	11.5	16.0	V
ゲートしきい値電圧 2	V_{th2}	$V_{DS} = 3.5\text{ V}, I_{DS} = 1.4\text{ mA}$	1.15	1.40	1.65	V
相互コンダクタンス 2	g_{m2}	$V_{DS} = 3.5\text{ V}, I_{DS} = 25\text{ mA}$	50	70	-	mS
PA 部 (Q3)						
オン抵抗 3	R_{on3}	$V_{DS} = 0.1\text{ V}, V_{GS} = 6\text{ V}$	-	1.02	-	Ω
ドレイン・ソース間耐圧 3	BV_{DSS3}	$I_{DS} = 8.0\ \mu\text{A}$	10.0	12.0	16.0	V
ゲート・ソース間耐圧 3	BV_{GSS3}	$I_{GS} = 8.0\ \mu\text{A}$	6.0	11.5	16.0	V
ゲートしきい値電圧 3	V_{th3}	$V_{DS} = 3.5\text{ V}, I_{DS} = 8.0\text{ mA}$	1.15	1.40	1.65	V
相互コンダクタンス 3	g_{m3}	$V_{DS} = 3.5\text{ V}, I_{DS} = 150\text{ mA}$	290	370	-	mS

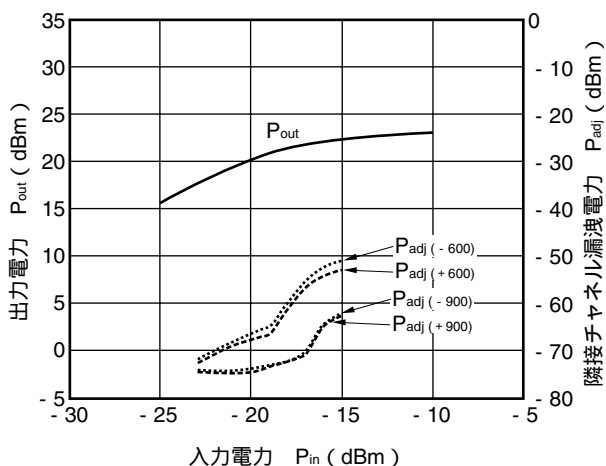
測定回路



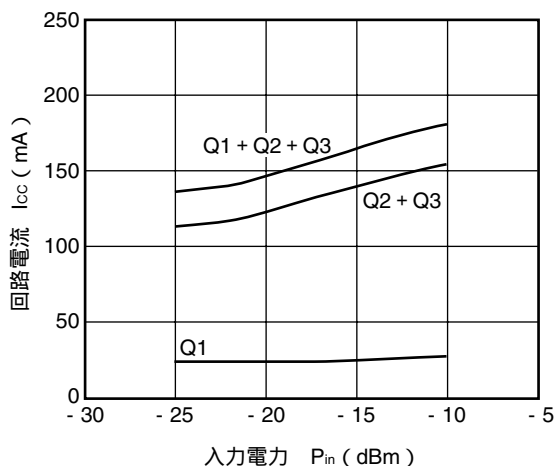
備考 裏面は GND

特性曲線 (特に指定のないかぎり $f = 1.9 \text{ GHz}$, $V_{DS} = V_{CC} = 3 \text{ V}$, $T_A = +25^\circ\text{C}$, 参考値)

出力電力, 隣接チャネル漏洩電力 vs. 入力電力

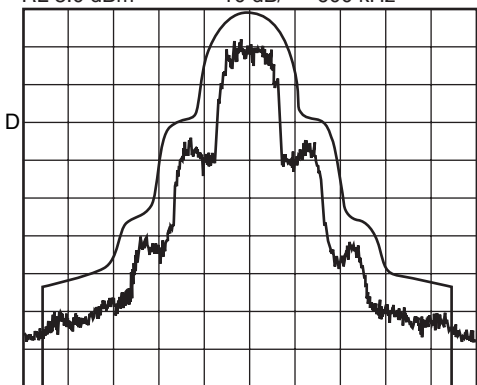


回路電流 vs. 入力電力



隣接チャネル漏洩電力

ATTEN 20 dB $\Delta\text{MKR} - 67.00 \text{ dB}$
 RL 5.0 dBm 10 dB/ 600 kHz



CENTER 1.900000 GHz SPAN 2.000 MHz
 *RBW 1.0 kHz *VBW 3.0 kHz *SWP 10.0 sec

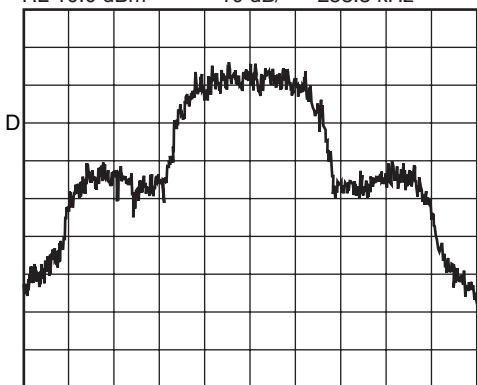
$P_{out} = 20.5 \text{ dBm}$, $P_{in} = -19 \text{ dBm}$
 $P_{adj} (+600 \text{ kHz}) = -67.0 \text{ dBc}$
 $P_{adj} (+900 \text{ kHz}) = -73.3 \text{ dBc}$

測定条件

Signal Generator	Spectrum Analyzer
Anritsu MG3670B	HP8561E
MOD : $\pi/4\text{DQPSK}$	PBW : 1.0 kHz
bit rate : 384 kbps	VBW : 3.0 kHz
Source : internal	SPAN : 2 MHz
Filter : RNYQ	SWP : 10 sec
Roll Off: 0.5	ATT : > 10 dB
Phase Encode : Normal	Channel-SP : 600 kHz
Burst : Off	Channel-BW : 192 kHz
Pattern : PN9	

占有周波数帯

ATTEN 20 dB $\Delta\text{MKR} 84 \text{ dB}$
 RL 10.0 dBm 10 dB/ 253.3 kHz



CENTER 1.900000 GHz SPAN 800.0 kHz
 *RBW 1.0 kHz *VBW 1.0 kHz *SWP 2.40 sec

$P_{out} = 20.5 \text{ dBm}$, $P_{in} = -19 \text{ dBm}$

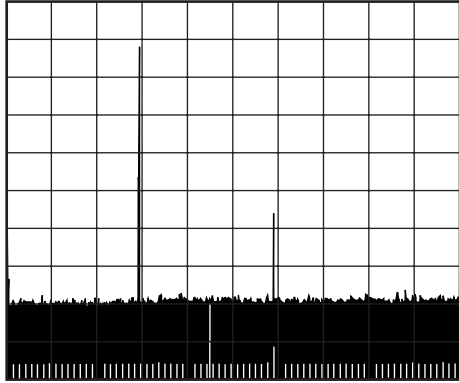
測定条件

Signal Generator	Spectrum Analyzer
Anritsu MG3670B	HP8561E
MOD : $\pi/4\text{DQPSK}$	PBW : 1.0 kHz
bit rate : 384 kbps	VBW : 1.0 kHz
Source : internal	SPAN : 800 kHz
Filter : RNYQ	SWP : 2.4 sec
Roll Off: 0.5	Signal : < 5 dB form
Phase Encode : Normal	REF Level
Burst : Off	
Pattern : PN9	

備考 グラフ中の値は参考値を示します。

高調波レベル

ATTEN 30 dB ΔMKR - 43.50 dB
 RL 20.0 dBm 10 dB/ 1.928 GHz



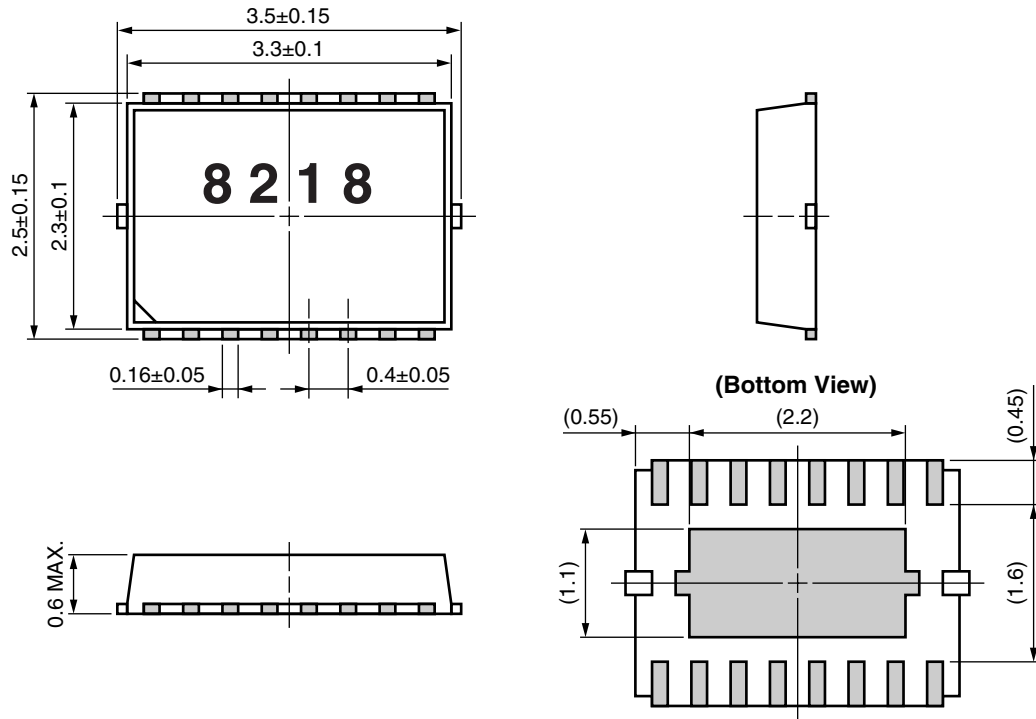
CENTER 3.250 GHz SPAN 6.500 GHz
 *RBW 30 kHz *VBW 30 kHz *SWP 19.0 sec

$P_{out} = 20.5 \text{ dBm}$, $P_{in} = -19 \text{ dBm}$
 $2f_0 = -43.5 \text{ dBc}$
 $3f_0 < -60 \text{ dBc}$

備考 グラフ中の値は参考値を示します。

外形図

16ピン・プラスチック TSON (単位 : mm)



備考 カッコ内寸法は参考値

使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) V_{CC} 端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 260°C 以下 ・ 最高温度の時間 : 10 秒以内 ・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内 ・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒 ・ 最多次リフロ回数 : 3 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	IR260
ウェーブ・ソルダリング	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (溶融半田温度) : 260°C 以下 ・ フロー時間 : 10 秒以内 ・ プリヒート温度 (パッケージ表面温度) : 120°C 以下 ・ フロー回数 : 1 回 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最高温度 (端子部温度) : 350°C 以下 ・ 時間 (デバイスの一辺あたり) : 3 秒以内 ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 (質量百分率) : 0.2% (Wt.) 以下 	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください (ただし、端子部分加熱は除く)。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
 - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
 - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
 - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先

営業本部 事業推進グループ TEL：044-435-1573
E-mail：salesinfo@ml.ncsd.necel.com
FAX：044-435-1579

技術に関する問い合わせ先

営業本部 販売技術グループ TEL：044-435-1577
E-mail：techinfo@ml.ncsd.necel.com
FAX：044-435-1918